

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年8月23日(2012.8.23)

【公開番号】特開2012-54335(P2012-54335A)

【公開日】平成24年3月15日(2012.3.15)

【年通号数】公開・登録公報2012-011

【出願番号】特願2010-194455(P2010-194455)

【国際特許分類】

H 01 L 21/203 (2006.01)

H 01 L 29/786 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/203 S

H 01 L 29/78 6 1 8 B

【手続補正書】

【提出日】平成24年7月6日(2012.7.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

インジウム(  $I_n$  )と、亜鉛(  $Z_n$  )と、金属元素X( 但し、Xは $T_i$ を表す )と、酸素( O )とからなる酸化物焼結体であって、インジウム(  $I_n$  )、亜鉛(  $Z_n$  )、及び金属元素Xの原子数比がそれぞれ、 $0.2 I_n / ( I_n + Z_n + X ) = 0.8, 0.1 Z_n / ( I_n + Z_n + X ) = 0.5$ 、及び $0.2 X / ( I_n + Z_n + X ) = 0.5$ を満たし、且つ、バルク抵抗が $3 m \text{ cm}$ 以下である酸化物焼結体。

【請求項2】

相対密度が98%以上である請求項1に記載の酸化物焼結体。

【請求項3】

$0.2$ ( 但し、 $0.2$ を除く ) $X / ( I_n + Z_n + X ) = 0.35$ であり、且つ、バルク抵抗が $2.5 m \text{ cm}$ 以下である請求項1又は2に記載の酸化物焼結体。

【請求項4】

インジウム(  $I_n$  )と、亜鉛(  $Z_n$  )と、金属元素X( 但し、Xは $T_i$ を表す )と、酸素( O )とからなる酸化物半導体薄膜であって、インジウム(  $I_n$  )、亜鉛(  $Z_n$  )、金属元素Xの原子数比が、 $0.2 I_n / ( I_n + Z_n + X ) = 0.8, 0.1 Z_n / ( I_n + Z_n + X ) = 0.5, 0.1 X / ( I_n + Z_n + X ) = 0.5, 0.2$ ( 但し、 $0.2$ を除く ) $X / ( I_n + Z_n + X ) = 0.35$ を満たし、且つ、非晶質である酸化物半導体薄膜。

【請求項5】

キャリア濃度が $10^{16} \sim 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ である請求項4に記載の酸化物半導体薄膜。

【請求項6】

移動度が $1 \text{ cm}^2 / \text{V s}$ 以上である請求項4又は5に記載の酸化物半導体薄膜。

【請求項7】

請求項4～6の何れか一項に記載の酸化物半導体薄膜を活性層として備えた薄膜トランジスタ。

【請求項8】

請求項7記載の薄膜トランジスタを備えたアクティブラチックス駆動表示パネル。

## 【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0023】

(酸化物焼結体の相対密度)

酸化物焼結体の相対密度は、スパッタ時の表面のノジュール発生と相関があり、酸化物焼結体が低密度であると、その酸化物焼結体をターゲットに加工してスパッタ成膜する際に、スパッタの成膜の経過に従って、表面にインジウムの低級酸化物である、突起状のノジュールと呼ばれる高抵抗部分が発生してきて、その後のスパッタ時に異常放電の起点となり易い。本発明では、酸化物焼結体の相対密度を98%以上とすることことができ、この程度の高密度であれば、スパッタ時のノジュールによる悪影響は殆どない。相対密度は好ましくは99%以上であり、より好ましくは99.5%以上である。

なお、酸化物焼結体の相対密度は、酸化物焼結体を所定の形状に加工した後の重量と外形寸法より算出した密度を、その酸化物焼結体の理論密度で除することで求めることができます。